

画面印刷

閉じる

■ ダウンロード項目を選択してください

ダウンロード形式

- 印刷用形式(検索式付き)
- タブ区切り形式(検索式なし)
- Refer/BibIX形式(検索式なし)

チェックした回答をダウンロード

■ 表示している文献の複写申し込み

チェックした回答の複写を申し込む

文献複写には別途料金がかかります

■ 検索対象データベース

JSTPlus ( 21,853,765 件 2010.07.08 現在 最新レンジ: 201013 )

■ 検索条件

	著者名(*)	日野太郎
AND	和文標題	膜

ヒット件数: 74 件

全てをチェックする

ANSWER 3 OF 74 JSTPLUS JST COPYRIGHT

整理番号:05A0428425

和文標題:LB膜MIMの抵抗と最大エネルギー放出

著者名:串田正人(千葉大 工), 日野太郎(東京工大), 日野浩二

資料名:応用物理学関係連合講演会講演予稿集 JST資料番号:Y0054A

巻号ページ(発行年月日):Vol.52nd No.3 Page.1382 (2005.03.29) 写図表参:写図1, 参1

資料種別:会議録(C) 記事区分:短報(a2)

発行国:日本(JPN) 言語:日本語(JA)

分類コード:BM03087F, BK14070L (621.382 MIM, 539.23:547)

シソーラス用語:\*MIM構造, \*有機伝導体, 電荷移動錯体, アルミニウム, 金, 電極, \*電気抵抗率, 等価回路, キノイド化合物, ジエン, ニトリル, 脂環式化合物, オレフィン化合物, 硫黄複素環化合物, \*Langmuir-Blodgett膜

準シソーラス用語:\*LB膜

物質索引:TCNQ ([J38.157H](#), 1518-16-7), TTF ([J316F](#), 31366-25-3), BEDO-TTF ([J894.159I](#), 120120-58-3)

▲このページの先頭へ

ANSWER 4 OF 74 JSTPLUS JST COPYRIGHT

整理番号:04A0753201

和文標題:Au/C12TCNQとBEDT-TTFの混合LB膜/Alからのエネルギー放出

著者名:串田正人, 日野浩二(千葉大), 日野太郎(東京工大)

資料名:電気学会基礎・材料・共通部門大会講演論文集 JST資料番号:L3783A

巻号ページ(発行年月日):Vol.2004 Page.39 (2004.08.30) 写図表参:写図4, 参1

資料種別:会議録(C) 記事区分:短報(a2)  
発行国:日本(JPN) 言語:日本語(JA)  
分類コード:BM03087F (621.382 MIM)  
シソーラス用語:\*MIM構造, エネルギー変換, 電圧発生, 時間依存性, 電極, 仕事関数, \*Langmuir-Blodgett膜  
準シソーラス用語:\*LB膜

▲このページの先頭へ

ANSWER 5 OF 74 JSTPLUS JST COPYRIGHT

整理番号:04A0753200  
和文標題:コンデンサに依るLB膜MIMのエネルギー発生の検討  
著者名:日野浩二, 串田正人(千葉大 工), 日野太郎(東京工大)  
資料名:電気学会基礎・材料・共通部門大会講演論文集 JST資料番号:L3783A  
巻号ページ(発行年月日):Vol.2004 Page.38 (2004.08.30) 写図表参:写図5, 参2  
資料種別:会議録(C) 記事区分:短報(a2)  
発行国:日本(JPN) 言語:日本語(JA)  
分類コード:BM03087F (621.382 MIM)  
シソーラス用語:\*MIM構造, ポリイミド, エネルギー変換, コンデンサ, 電圧発生, 時間依存性, \*Langmuir-Blodgett膜  
準シソーラス用語:\*LB膜

▲このページの先頭へ

ANSWER 6 OF 74 JSTPLUS JST COPYRIGHT

整理番号:04A0284264  
和文標題:Au/C12TCNQとBEDT-TTFの混合LB膜/AIからのエネルギー放出  
著者名:串田正人(千葉大), 日野太郎(東京工大), 日野浩二  
資料名:電気学会全国大会講演論文集 JST資料番号:S0653A  
巻号ページ(発行年月日):Vol.2004 No.2 Page.113 (2004.03.17) 写図表参:写図4, 表1, 参2  
資料種別:会議録(C) 記事区分:短報(a2)  
発行国:日本(JPN) 言語:日本語(JA)  
分類コード:BK14070L (539.23:547)  
シソーラス用語:\*MIM構造, 超薄膜, エネルギー変換, \*電流電圧特性, 金, アルミニウム, 電圧発生, キノイド化合物, ジェン, ニトリル, 脂環式化合物, オレフィン化合物, 硫黄複素環化合物, \*Langmuir-Blodgett膜  
準シソーラス用語:\*LB膜, エネルギー放出, C12TCNQ  
物質索引:TCNQ ([J38.157H](#), 1518-16-7), BEDT-TTF ([J133.904D](#), 66946-48-3)

▲このページの先頭へ

ANSWER 7 OF 74 JSTPLUS JST COPYRIGHT

整理番号:04A0284263  
和文標題:LB膜のMIMからのエネルギー放出とその機構  
著者名:串田正人(千葉大 工), 日野太郎(東京工大), 日野浩二  
資料名:電気学会全国大会講演論文集 JST資料番号:S0653A

巻号ページ(発行年月日):Vol.2004 No.2 Page.112 (2004.03.17) 写図表参:写図4, 参2

資料種別:会議録(C) 記事区分:短報(a2)

発行国:日本(JPN) 言語:日本語(JA)

分類コード:BK14070L (539.23:547)

シソーラス用語:\*MIM構造, 超薄膜, ポリイミド, エネルギー変換, \*電流電圧特性, 電圧発生, \*Langmuir-Blodgett膜

準シソーラス用語:\*LB膜, エネルギー放出

▲このページの先頭へ

---

ANSWER 8 OF 74 JSTPLUS JST COPYRIGHT

整理番号:03A0731747

和文標題:ポリイミドLB膜MIM'のエネルギー放出機構

著者名:串田正人(千葉大 工), 日野太郎(東京工大), 日野浩二

資料名:電気学会基礎・材料・共通部門大会講演論文集 JST資料番号:L3783A

巻号ページ(発行年月日):Vol.2003 Page.103 (2003.08.25) 写図表参:写図3, 表1, 参4

資料種別:会議録(C) 記事区分:短報(a2)

発行国:日本(JPN) 言語:日本語(JA)

分類コード:YH07150C, BM03087F (678.5/.8, 621.382 MIM)

シソーラス用語:\*ポリイミド, \*MIM構造, 放射エネルギー, 電圧発生, エネルギー変換, 仕事関数, バンド構造, \*Langmuir-Blodgett膜, バンドギャップ

準シソーラス用語:\*LB膜, 禁止帯, エネルギー放出, 拡散電流

▲このページの先頭へ

---

ANSWER 9 OF 74 JSTPLUS JST COPYRIGHT

整理番号:03A0731746

和文標題:ポリイミドLB膜MIM'のエネルギー放出

著者名:串田正人(千葉大 工), 日野太郎(東京工大), 日野浩二

資料名:電気学会基礎・材料・共通部門大会講演論文集 JST資料番号:L3783A

巻号ページ(発行年月日):Vol.2003 Page.102 (2003.08.25) 写図表参:写図4, 参4

資料種別:会議録(C) 記事区分:短報(a2)

発行国:日本(JPN) 言語:日本語(JA)

分類コード:YH07150C, BM03087F (678.5/.8, 621.382 MIM)

シソーラス用語:\*ポリイミド, \*MIM構造, 放射エネルギー, 電圧発生, 温度依存性, 不活性ガス, \*Langmuir-Blodgett膜

準シソーラス用語:\*LB膜, エネルギー放出

▲このページの先頭へ

---

ANSWER 12 OF 74 JSTPLUS JST COPYRIGHT

整理番号:02A0820303

和文標題:室温でAl超薄膜に現れる抵抗の消滅と反磁性

著者名:日野浩二(富士電機), 日野太郎

資料名:電気学会基礎・材料・共通部門大会講演論文集 JST資料番号:L3783A

巻号ページ(発行年月日):Vol.2002 Page.488 (2002.09.11) 写図表参:写図4, 参1

資料種別:会議録(C) 記事区分:短報(a2)

発行国:日本(JPN) 言語:日本語(JA)

分類コード:BK14030T (539.23:669)

シソーラス用語:\*超薄膜, 金属薄膜, \*アルミニウム, 蒸着膜, 電気抵抗, \*反磁性, 電流電圧特性, 変位

▲このページの先頭へ

ANSWER 14 OF 74 JSTPLUS JST COPYRIGHT

整理番号:98A0965237

和文標題:誘電体超薄膜MIMの長期電力量発生

英文標題:Generated Power in Ultrathin Dielectric Film MIM Structures.

著者名:日野太郎, 竹内茂, 小野建太郎 (神奈川大)

資料名:電気学会論文誌 A JST資料番号:S0808A ISSN:0385-4205

巻号ページ(発行年月日):Vol.118-A No.10 Page.1078-1082 (1998.10) 写図表参:写図11, 参6

資料種別:逐次刊行物(A) 記事区分:原著論文(a1)

発行国:日本(JPN) 言語:日本語(JA)

抄録:誘電体超薄膜としてポリイミドLangmuir-Blodgett膜(ポリイミドLB膜,PI),アラキジン酸LB膜(C<sub>20</sub>,Y型)および2-pentadecyl-7,7',8,8'-teracyanoquinodimethaneLB膜(C<sub>15</sub>-TCNQ,Z型)を用いて顕微鏡のスライドガラスの基板上に[金属/絶縁膜/金属]構造(MIM)を作製した。このようなMIMの両電極間に抵抗を接続したとき,この抵抗に減衰のない直流電圧が発生し,この電圧が2年間以上も発生し続けた。この電圧発生時の定常状態を解析した。

分類コード:NA04030W, BM03087F (621.315.6, 621.382 MIM)

シソーラス用語:\*誘電体薄膜, 超薄膜, \*MIM構造, 電力消費, ポリイミド, 電圧発生, 金電極, アルミニウム, 直流電圧, 電圧測定, 絶縁膜, \*Langmuir-Blodgett膜

準シソーラス用語:\*LB膜, 誘電体超薄膜

▲このページの先頭へ

ANSWER 15 OF 74 JSTPLUS JST COPYRIGHT

整理番号:98A0882226

和文標題:誘電体超薄膜MIM電源

英文標題:MIM Electrical Source of Ultrathin Dielectric Film.

著者名:竹内茂, 吉橋悟, 日野太郎 (神奈川大)

資料名:電気学会論文誌 A JST資料番号:S0808A ISSN:0385-4205

巻号ページ(発行年月日):Vol.118-A No.9 Page.1049-1052 (1998.09) 写図表参:写図7, 参4

資料種別:逐次刊行物(A) 記事区分:原著論文(a1)

発行国:日本(JPN) 言語:日本語(JA)

抄録:絶縁超薄膜であるポリイミドLB膜をアルミニウムと金の蒸着膜で挟んだMIMが電源であることを確かめるために,MIMの電圧-電流特性を求めた。すなわちMIMに電池から電圧を印加してそこに流れる電流を調べた。その結果,0-400mVの正の範囲の電圧を印加したところ,電流は電圧の方向とは逆で負の値( $-1 \times 10^{-13}$ A)であった。このことはMIMから電池に電力を供給していることを示していてMIMが電源となっていることを意味している。また電源となる機構も検討した。

分類コード:NC05060Q, BM03085X (621.311.6, 621.382 MIS)

シソーラス用語:\*直流電源, 誘電体, \*ポリイミド, 超薄膜, \*Langmuir膜, 蒸着膜, アルミニウム, 金, \*MIM構造, 電流電圧特性, \*熱電気変換

[▲このページの先頭へ](#) ANSWER 17 OF 74 JSTPLUS JST COPYRIGHT

整理番号:98A0224860

和文標題:誘電体超薄膜MIMの初期発生電圧の解析

英文標題:Analysis of the Voltage Generated in Early Stage in Metal-Ultrathin Dielectric Film-Metal Structures.

著者名:竹内茂, 吉橋悟, 日野太郎 (神奈川大)

資料名:電気学会論文誌 A JST資料番号:S0808A ISSN:0385-4205

巻号ページ(発行年月日):Vol.118-A No.1 Page.78-81 (1998.01) 写図表参:写図5, 表1, 参5

資料種別:逐次刊行物(A) 記事区分:原著論文(a1)

発行国:日本(JPN) 言語:日本語(JA)

抄録:誘電体超薄膜MIMの両電極の短絡を開くと電圧が発生したが、この電圧が発生してもキャリアが電界と逆方向に移動している。これはキャリアの拡散によるものと考えられていた。このような現象に対し電圧発生初期段階を解析し、実験と比較した。外部装入抵抗が大きくなるほど発生電圧が最大となる時間は増大し、最大の発生電圧は大きくなることは両者よく一致していたが、それらの値は相当な違いがみられた。これはAuとAlの仕事関数の差や試料の内部抵抗の発生電圧による変化等によると述べた。

分類コード:BK14070L (539.23:547)

シソーラス用語:\*Langmuir膜, \*超薄膜, 多層構造, ポリイミド, アルミニウム, 金, 電極, 真空蒸着, \*接触電位差, 仕事関数, 誘電体, 脂肪族カルボン酸

準シソーラス用語:エイコサン酸

[▲このページの先頭へ](#) ANSWER 18 OF 74 JSTPLUS JST COPYRIGHT

整理番号:97A0422509

和文標題:LB膜MIMの電圧発生に伴う温度低下

英文標題:Temperature Decrease Caused by Voltage Generation in MIM of LB Film.

著者名:竹内茂, 小野建太郎, 日野太郎 (神奈川大)

資料名:電気学会全国大会講演論文集 JST資料番号:S0653A

巻号ページ(発行年月日):Vol.1997 No.2 Page.2.276 (1997.03)

資料種別:会議録(C)

発行国:日本(JPN) 言語:日本語(JA)

[▲このページの先頭へ](#) ANSWER 19 OF 74 JSTPLUS JST COPYRIGHT

整理番号:97A0422508

和文標題:LB膜MIMからの発生電力

英文標題:Generated Power in MIM of LB Film.

著者名:竹内茂, 吉橋悟, 日野太郎 (神奈川大)

資料名:電気学会全国大会講演論文集 JST資料番号:S0653A

巻号ページ(発行年月日):Vol.1997 No.2 Page.2.275 (1997.03)

資料種別:会議録(C)

発行国:日本(JPN) 言語:日本語(JA)

[▲このページの先頭へ](#) ANSWER 21 OF 74 JSTPLUS JST COPYRIGHT

整理番号:97A0165503

和文標題:LBヘテロ膜MIM積層の発生電圧

英文標題:Generated voltage in laminated sample of MIM structures of LB heterofilm.

著者名:大石晃, 竹内茂, 日野太郎 (神奈川大)

資料名:電気学会全国大会講演論文集 JST資料番号:S0653A

巻号ページ(発行年月日):Vol.1996 No.2 Page.2.41-2.42 (1996.03)

資料種別:会議録(C)

発行国:日本(JPN) 言語:日本語(JA)

[▲このページの先頭へ](#) ANSWER 22 OF 74 JSTPLUS JST COPYRIGHT

整理番号:97A0120245

和文標題:LB膜MIMの発生電圧温度特性

英文標題:Temperature Dependence of Voltage Generated in MIM Structures of LB Films.

著者名:竹内茂, 日野太郎 (神奈川大)

資料名:電気学会全国大会講演論文集 JST資料番号:S0653A

巻号ページ(発行年月日):Vol.1995 No.2 Page.2.54-2.55 (1995.03)

資料種別:会議録(C)

発行国:日本(JPN) 言語:日本語(JA)

[▲このページの先頭へ](#) ANSWER 23 OF 74 JSTPLUS JST COPYRIGHT

整理番号:96A0046709

和文標題:LBヘテロ膜MIMの直・並列接続の電流源特性

英文標題:Current Source Characteristics in Series and Parallel Connection of MIM of LB Heterofilms.

著者名:日野太郎, 竹内茂 (神奈川大)

資料名:電気学会論文誌 A JST資料番号:S0808A ISSN:0385-4205

巻号ページ(発行年月日):Vol.115 No.12 Page.1197-1202 (1995.12) 写図表参:写図11, 表1, 参4

資料種別:逐次刊行物(A) 記事区分:原著論文(a1)

発行国:日本(JPN) 言語:日本語(JA)

抄録:アラキジン酸LB膜(C<sub>20</sub>)とC<sub>15</sub>・TCNQLB膜(TCNQ)から成るLBヘテロ膜のMIMの単独,直列接続,並列接続などについて,発生電圧の特性を検討した。その結果,LB膜内でキャリア電子が拡散するために,これらMIMが電流源として動作していると考えられることが分かった

分類コード:BM03087F (621.382 MIM)

シソーラス用語:Langmuir膜, MIM構造, 多層構造, 直列接続, 並列接続, キャリア拡散, 起電力, アルミニウム, 蒸着膜, 電流電圧特性, 電気測定, 脂肪酸カルボン酸, ニトリル, キノイド化合物

準シソーラス用語:電流源, エイコサン酸, テトラシアノキノジメタン

[▲このページの先頭へ](#) ANSWER 24 OF 74 JSTPLUS JST COPYRIGHT

整理番号:96A0046708

和文標題:LBヘテロ膜MIMの発生電圧温度特性

英文標題:Temperature Characteristics of Voltage Generated in MIM of LB Heterofilms.

著者名:日野太郎, 竹内茂 (神奈川大)

資料名:電気学会論文誌 A JST資料番号:S0808A ISSN:0385-4205

巻号ページ(発行年月日):Vol.115 No.12 Page.1191-1196 (1995.12) 写図表参:写図11, 参7

資料種別:逐次刊行物(A) 記事区分:原著論文(a1)

発行国:日本(JPN) 言語:日本語(JA)

抄録:試料の外部回路に抵抗を接続して,それに発生する電圧を測定した。温度上昇とともにこの電圧が増加する場合と減少するときがあって,この現象は回路に入れる抵抗の値に関係していた。本試料MIMをキャリアのLB膜内での拡散による電流源として発生電圧の温度特性を解析して,測定された特性をほぼ説明することができた

分類コード:BM03087F (621.382 MIM)

シソーラス用語:Langmuir膜, 多層構造, MIM構造, 抵抗回路, 起電力, 温度依存性, キャリア拡散, アルミニウム, 蒸着膜, 電気測定, 電圧測定, 脂肪酸カルボン酸, ニトリル, キノイド化合物

準シソーラス用語:エイコサン酸, テトラシアノキノジメタン

[▲このページの先頭へ](#) ANSWER 25 OF 74 JSTPLUS JST COPYRIGHT

整理番号:95A0808896

和文標題:ポリイミドLB膜MIMの発生電圧温度特性

英文標題:Temperature Characteristics of Voltage Generated in MIM Structure of Polyimide LB Films.

著者名:日野太郎, 竹内茂 (神奈川大)

資料名:電気学会論文誌 A JST資料番号:S0808A ISSN:0385-4205

巻号ページ(発行年月日):Vol.115 No.9 Page.811-816 (1995.09) 写図表参:写図12, 参6

資料種別:逐次刊行物(A) 記事区分:原著論文(a1)

発行国:日本(JPN) 言語:日本語(JA)

抄録:ポリイミドLB膜を用いたMIM(金属/絶縁体/金属)試料の発生電圧の温度依存性を測定し,拡散電流と伝導電流による計算を行い,実測値と照合した。その結果,LB膜中での電子の拡散を用いた理論計算とほぼ合っていた。このことは,発生電圧がキャリアのLB膜内での拡散によることを示すものと推定される

分類コード:NC03010Z, BM03087F (621.382, 621.382 MIM)

シソーラス用語:Langmuir膜, ポリイミド, MIM構造, 電圧, 温度依存性, 電流電圧特性, 絶縁膜, 電気伝導率, キャリア拡散

[▲このページの先頭へ](#) ANSWER 26 OF 74 JSTPLUS JST COPYRIGHT

整理番号:95A0769021

和文標題:LBヘテロ膜MIMの発生電圧解析

**英文標題:**Analysis of the Voltage Generated in MIM Structures of LB Heterofilms.

**著者名:**日野太郎, 竹内茂 (神奈川大)

**資料名:**電気学会論文誌 A **JST資料番号:**S0808A **ISSN:**0385-4205

**巻号ページ(発行年月日):**Vol.115 No.8 Page.704-709 (1995.08) **写図表参:**写図11, 参3

**資料種別:**逐次刊行物(A) **記事区分:**原著論文(a1)

**発行国:**日本(JPN) **言語:**日本語(JA)

**抄録:**ポリイミド膜をAlでサンドイッチしたMIM素子の標記現象について検討した。アラキジン酸LB膜(C<sub>20</sub>)でC<sub>15</sub>-TCNQのLB膜を挟んだ形の標記MIMを作成し,試料を電流源とみて発生電圧と抵抗の関係式を導出した。発生電圧の電子性キャリアの挙動,短絡と拡散現象の関係,TCNQの分子の双極子モーメントに基づく発生電圧現象の解析結果を示し論議した

**分類コード:**BM03087F (621.382 MIM)

**シソーラス用語:**Langmuir膜, MIM構造, 電極, ポリイミド, サンドイッチ構造, 時間依存性, 電圧発生, キャリア移動度, 拡散係数, 双極子モーメント, 高分子膜, 脂肪族カルボン酸, ニトリル, キノイド化合物

**準シソーラス用語:**エイコサン酸, テトラシアノキノジメタン

▲このページの先頭へ

ANSWER 27 OF 74 JSTPLUS JST COPYRIGHT

**整理番号:**95A0218948

**和文標題:**ポリイミドLB膜MIM素子の発生電圧雰囲気効果

**英文標題:**Effects of Atmosphere on Voltage Generated in MIM Elements of Polyimide LB Films.

**著者名:**日野太郎 (神奈川大)

**資料名:**電気学会論文誌 A **JST資料番号:**S0808A **ISSN:**0385-4205

**巻号ページ(発行年月日):**Vol.115 No.2 Page.115-120 (1995.02) **写図表参:**写図11, 参6

**資料種別:**逐次刊行物(A) **記事区分:**原著論文(a1)

**発行国:**日本(JPN) **言語:**日本語(JA)

**抄録:**ポリイミドLB膜のMIM素子の電圧発生現象についてはすでに報告した。今回は,AlとAuでサンドイッチしたMIM構造の素子で,1986-1987年に作製され,そのまま現在まで大気に放置されていた試料について,発生電圧に対する雰囲気の効果調べた

**分類コード:**CG02024U, BM03087F (544.23-16:535/538, 621.382 MIM)

**シソーラス用語:**ポリイミド, Langmuir膜, 雰囲気, ヘリウム, 窒素, アルミニウム, 金, MIM構造, 電圧発生, 時間依存性, 空気, 圧力効果

**準シソーラス用語:**圧力依存性

▲このページの先頭へ

ANSWER 28 OF 74 JSTPLUS JST COPYRIGHT

**整理番号:**95A0060721

**和文標題:**拡散電流によるポリイミドLB膜MIM構造の発生電圧解析

**英文標題:**Analysis of Voltage Generated in MIM Structures of Polyimide LB Films by Diffusion Current.

**著者名:**日野太郎 (神奈川大)

**資料名:**電気学会論文誌 A **JST資料番号:**S0808A **ISSN:**0385-4205

**巻号ページ(発行年月日):**Vol.114 No.12 Page.875-879 (1994.12) **写図表参:**写図10, 参6

**資料種別:**逐次刊行物(A) **記事区分:**原著論文(a1)

**発行国:**日本(JPN) **言語:**日本語(JA)

**抄録:**ポリイミドLB膜をAlとAuの異種金属でサンドイッチしたMIM構造試料の電圧発生機構について検討した。AlとAuの仕事関数の差,キャリア(電子)のLB膜内での拡散,電圧発生による電極間のキャリアの伝導などの効果を基に,外部電流



により発生する電圧を計算して測定値と良い一致を得た。これは発生電圧がキャリアの拡散によるためと考えられる

**分類コード:**CG02024U, BM03087F (544.23-16:535/538, 621.382 MIM)

**シソーラス用語:**Langmuir膜, ポリイミド, MIM構造, サンドイッチ構造, アルミニウム, 金, 電圧発生, 仕事関数, キャリア拡散, キャリア密度, 拡散係数, バンド構造, 電流電圧特性

▲このページの先頭へ

ANSWER 29 OF 74 JSTPLUS JST COPYRIGHT

**整理番号:**94A0881601

**和文標題:**特集: 熱プラズマ LBヘテロ膜MIM構造の発生電圧とキャリアの拡散

**英文標題:**Generated Voltage in MIM Structures of LB Heterofilm and Diffusion of Carriers.

**著者名:**日野太郎, 竹内茂, 大石晃 (神奈川大)

**資料名:**電気学会論文誌 A **JST資料番号:**S0808A **ISSN:**0385-4205

**巻号ページ(発行年月日):**Vol.114 No.10 Page.673-678 (1994.10) **写図表参:**写図8, 参10

**資料種別:**逐次刊行物(A) **記事区分:**原著論文(a1)

**発行国:**日本(JPN) **言語:**日本語(JA)

**抄録:**無極性のアラキジン酸LB膜と有極性のTCNQのLB膜を重ねたLBヘテロ膜のMIM試料に発生する電圧を検討した。発生電圧の時間特性, LB膜内のキャリア移動, 電子の拡散定数, 拡散電流の測定結果に基づいて考察し, 電圧発生の原因として, TCNQのLB膜の分極及び電子性キャリアのLB膜内への拡散が考えられると述べた

**分類コード:**NC03010Z, BM03087F (621.382, 621.382 MIM)

**シソーラス用語:**MIM構造, アルミニウム, Langmuir膜, 電荷分布, キャリア拡散, 時間依存性, 分極, 電圧発生, 脂肪族カルボン酸, ニトリル, キノイド化合物

**準シソーラス用語:**エイコサン酸, テトラシアノキノジメタン

▲このページの先頭へ

ANSWER 30 OF 74 JSTPLUS JST COPYRIGHT

**整理番号:**94A0806339

**和文標題:**LB超薄膜MIM構造における電圧発生

**英文標題:**Voltage generation in a LB superthin film MIM structure.

**著者名:**日野太郎, 竹内茂 (神奈川大)

**資料名:**電気学会誘電・絶縁材料研究会資料 **JST資料番号:**Z0908B

**巻号ページ(発行年月日):**Vol.DEI-94 No.51-58 Page.27-34 (1994.08.26) **写図表参:**写図12, 参3

**資料種別:**会議録(C) **記事区分:**原著論文(a1)

**発行国:**日本(JPN) **言語:**日本語(JA)

**抄録:**約10年前に作製されたAl/ポリイミドLB膜/AuのMIM構造素子を用い, 実験用回路により, 発生電圧, 平衡電圧およびキャリアの拡散について検討した。作製当初と変わらない0.1V程度の電圧を発生すること, この構造の素子には熱平衡電圧が存在すること, 電圧発生の原因はポリイミドLB膜中を拡散するキャリアによるものと思えること等を述べた

**分類コード:**NC03010Z, BM03087F (621.382, 621.382 MIM)

**シソーラス用語:**MIM構造, アルミニウム, ポリイミド, 金, Langmuir膜, 起電力, 直流電圧, 電気測定, キャリア拡散

▲このページの先頭へ

ANSWER 34 OF 74 JSTPLUS JST COPYRIGHT

整理番号:94A0049795

和文標題:LB膜のMIM構造に発生する直流電圧

英文標題:D.C. voltage generation in MIM structures of LB films.

著者名:日野太郎, 竹内茂 (神奈川大)

資料名:電子情報通信学会技術研究報告 JST資料番号:S0532B ISSN:0913-5685

巻号ページ(発行年月日):Vol.93 No.343(OME93 39-45) Page.13-18 (1993.11.25) 写図表参:写図10, 参2

資料種別:逐次刊行物(A) 記事区分:原著論文(a1)

発行国:日本(JPN) 言語:日本語(JA)

抄録:1986-1987年に作製されたポリイミドLB膜(7)をAlとAu電極でサンドイッチしたMIM試料に0.1V程度の直流電圧の発生することを示し,電圧発生に原因がLB膜あるいはLB膜と電極との化学反応によるものではないと云う考えを示すと共に,Au電極からLB膜を通してAl電極に向かう電子の拡散によって電圧が発生すると考えられる結果を示した。(著者抄録)

分類コード:BM03087F, BK14010X (621.382 MIM, 539.23)

シソーラス用語:Langmuir膜, 超薄膜, ポリイミド, アルミニウム, 金, MIM構造, 直流, 電圧, キャリア拡散

リンク情報:



▲このページの先頭へ

---

ANSWER 35 OF 74 JSTPLUS JST COPYRIGHT

整理番号:93A0368754

和文標題:LB超薄膜絶縁を用いたMIM構造における起電力発生 温度特性

著者名:権寧守 (東亜大学校), 竹内茂, 日野太郎 (神奈川大)

資料名:電気学会全国大会講演論文集 JST資料番号:S0653A

巻号ページ(発行年月日):Vol.1993 No.3 Page.3.197 (1993.03)

資料種別:会議録(C)

発行国:日本(JPN) 言語:日本語(JA)

▲このページの先頭へ

---

ANSWER 36 OF 74 JSTPLUS JST COPYRIGHT

整理番号:93A0368753

和文標題:LB超薄膜絶縁を用いたMIM構造における起電力発生 雰囲気ガスの圧力と種類の影響

著者名:権寧守 (東亜大学校), しょう道烈 (弘益大学校), 竹内茂, 日野太郎 (神奈川大)

資料名:電気学会全国大会講演論文集 JST資料番号:S0653A

巻号ページ(発行年月日):Vol.1993 No.3 Page.3.195-3.196 (1993.03)

資料種別:会議録(C)

発行国:日本(JPN) 言語:日本語(JA)

▲このページの先頭へ

---

ANSWER 37 OF 74 JSTPLUS JST COPYRIGHT

整理番号:93A0368752

和文標題:LB絶縁超薄膜を用いたMIM構造における起電力発生

著者名:竹内茂, 日野太郎(神奈川大), きゅう相勲(朝鮮大学校)

資料名:電気学会全国大会講演論文集 JST資料番号:S0653A

巻号ページ(発行年月日):Vol.1993 No.3 Page.3.193-3.194 (1993.03)

資料種別:会議録(C)

発行国:日本(JPN) 言語:日本語(JA)

▲このページの先頭へ

ANSWER 38 OF 74 JSTPLUS JST COPYRIGHT

整理番号:92A0276220

和文標題:超低抵抗LB薄膜

英文標題:An ultra-low resistance LB thin film.

著者名:日野太郎, 伊藤和哉(神奈川大)

資料名:電気学会全国大会講演論文集 JST資料番号:S0653A

巻号ページ(発行年月日):Vol.1992 No.3 Page.S.4.15-S.4.17 (1992.03) 写図表参:写図5, 表1, 参5

資料種別:会議録(C) 記事区分:原著論文(a1)

発行国:日本(JPN) 言語:日本語(JA)

抄録:Y形のアラキジン酸のLB膜(無極性)とZ形のTCNQのLB膜(有極性)とを重ねてヘテロ構造とし,Al,Auなどでサンドイッチ状に挟んで両方の金属膜を短絡すると超低抵抗を観測する。この実験方法と実験結果を述べる。TCNQの代わりに他のZ形LB膜でも同様の結果を得ること,積層LB膜の順序を逆にすると高抵抗になること,これらの現象の理論づけなどについて述べる

分類コード:BK14070L (539.23:547)

シソーラス用語:Langmuir膜, 多層膜, ウエハ【IC】, 金属薄膜, サンドイッチ構造, 電気抵抗, 静電誘導, ケイ素, アルミニウム, 銅, ニトリル, キノイド化合物, 脂肪族カルボン酸, Langmuir-Blodgett膜

準シソーラス用語:LB膜, テトラシアノキノジメタン, エイコサン酸

▲このページの先頭へ

ANSWER 39 OF 74 JSTPLUS JST COPYRIGHT

整理番号:92A0189473

和文標題:ラングミュア・プロジェクト ヘテロ膜における室温超伝導の可能性

英文標題:Possible Evidence for Superconduction at Room Temperature Observed in Langmuir-Blodgett-Heterofilms.

著者名:日野太郎(神奈川大 工研)

資料名:神奈川大学工学研究所所報 JST資料番号:G0032B ISSN:0387-0324

巻号ページ(発行年月日):No.14 Page.10-15 (1991.12) 写図表参:写図12, 表1, 参9

資料種別:逐次刊行物(A) 記事区分:原著論文(a1)

発行国:日本(JPN) 言語:日本語(JA)

抄録:TCNQのLB膜とアラキジン酸のLB膜とを重ねてヘテロ構造とし(共に四分子層または五分子層),これを極薄Al膜とAu膜とでサンドイッチ状に挟んで両方の金属膜を短絡すると,ヘテロ膜の面内方向に超低抵抗が観測される。基板として酸化したSiウエハを用いた。この超低抵抗の原因を探るために種々の電気特性(電圧分布,電流電圧特性,電流や電気抵抗の温度・圧力依存性など)を測定した。その結果,室温において超伝導の生じている可能性が高い。磁気特性はまだ測定してない

分類コード:BM04030U, CB12043P (537.312.67, 544.723:53.06)

**シソーラス用語:** 多層膜, Langmuir膜, 電位分布, 電流電圧特性, 電気抵抗, 電流, 温度依存性, 超伝導, 転移温度, 室温, 励起子, ニトリル, キノイド化合物, 脂肪族カルボン酸, 圧力効果  
**準シソーラス用語:** 圧力依存性, テトラシアノキノジメタン, エイコサン酸

▲このページの先頭へ

ANSWER 51 OF 74 JSTPLUS JST COPYRIGHT

**整理番号:** 89A0565288

**和文標題:** ポリイミドLB超薄膜コンデンサの特性

**英文標題:** Characteristics of a polyimide LB superthin film capacitor.

**著者名:** 串田正人, 杉田浩久, 高梨信一, 日野太郎 (神奈川大)

**資料名:** 電気学会絶縁材料研究会資料 **JST資料番号:** Z0908A

**巻号ページ(発行年月日):** Vol.EIM-89 No.73-79 Page.37-46 (1989.08.29) **写図表参:** 写図13, 表2, 参2

**資料種別:** 会議録(C) **記事区分:** 原著論文(a1)

**発行国:** 日本(JPN) **言語:** 日本語(JA)

**抄録:** ポリイミド(PI)LB超薄膜コンデンサの各種の特性を調べ,比較的大きい吸湿性の影響,Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>/PIのヘテロ絶縁膜による周波数特性,ヘテロ膜による極めて大きい耐電界性などを調べた。更に数10 Åの厚さのAl<sub>2</sub>O<sub>3</sub>/PIヘテロ超薄膜の絶縁性の機構とトンネル電流との関係を述べ,その実験と結果を示した。LB膜のみがトンネル障壁となっていることを実証した

**分類コード:** BK14070L, NA05030D (539.23:547, 621.316.8+621.318.3/.4)

**シソーラス用語:** Langmuir膜, 芳香族ポリイミド, 薄膜コンデンサ, 酸化アルミニウム, 積層構造, 絶縁膜, 絶縁耐力, 吸湿性, 電気伝導, トンネル効果, ポテンシャル障壁, 静電容量, 相対湿度, 電流電圧特性, 周波数依存性

**準シソーラス用語:** トンネル電流

▲このページの先頭へ

ANSWER 56 OF 74 JSTPLUS JST COPYRIGHT

**整理番号:** 89A0252918

**和文標題:** 絶縁超薄膜のトンネル伝導

**英文標題:** Tunnel effect conduction of an insulating super-thin film.

**著者名:** 小泉芳則, 串田正人, 日野太郎 (神奈川大)

**資料名:** 電気学会全国大会講演論文集 **JST資料番号:** S0653A

**巻号ページ(発行年月日):** Vol.1989 No.3 Page.3.109 (1989.04) **写図表参:** 写図4, 参2

**資料種別:** 会議録(C) **記事区分:** 短報(a2)

**発行国:** 日本(JPN) **言語:** 日本語(JA)

**抄録:** Al/Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>/Au, Al/Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>/ポリイミドLB膜/Alの構造のMIM形試料に,電源電圧の上昇及び下降の速度が一定の三角波電圧を周期60分で印加して電圧・電流特性を測定し,絶縁超薄膜のトンネル伝導を検討する。MIM素子において印加電圧が金属と絶縁体の界面の障壁より小さい範囲ではI<sub>s</sub>とI<sub>0</sub>の間には直線関係があり,トンネル伝導の特性である

**分類コード:** BM03076D, CG02024U (621.382 MIM, 544.23-16:535/538)

**シソーラス用語:** 絶縁膜, トンネル効果, 電気伝導, MIM構造, Langmuir膜, 電流電圧特性, 三角波, 線形性, ポテンシャル障壁, アルミニウム, アルミナ, 金, ポリイミド

▲このページの先頭へ

ANSWER 64 OF 74 JSTPLUS JST COPYRIGHT

整理番号:86A0525093

和文標題:4 Å厚ポリイミドLB超薄膜の作製とその累積膜の特性

英文標題:Preparation of LB ultra-thin polyimide film of 4 Å thickness and properties of build-up films.

著者名:鈴木正明, 岩本光正, 日野太郎, 柿本雅明, 今井よし夫 (東京工大)

資料名:電気学会論文誌 A JST資料番号:S0808A ISSN:0385-4205

巻号ページ(発行年月日):Vol.106 No.9 Page.435-441 (1986.09) 写図表参:写図14, 表2, 参15

資料種別:逐次刊行物(A) 記事区分:原著論文(a1)

発行国:日本(JPN) 言語:日本語(JA)

抄録:ポリイミドの前駆体であるポリアミド酸に長鎖アルキル基を付与して単分子膜を形成して,基板上に累積した後にイミド化を行なって長鎖を取り去り,ポリイミドLB膜を作製した。このLB膜の基板との付着力や耐熱性は良好であった。比誘電率,抵抗率,耐電圧などの基礎的電気特性は従来のポリイミド樹脂と同程度で,実用的材料として期待できる

分類コード:NC03020K, YH07150C (621.315.5, 678.5/.8)

シソーラス用語:有機材料, 高分子膜, 膜厚, 単分子層, 累積, 浸漬, 高分子加工, 吸収スペクトル, X線回折, 電流電圧特性, 静電容量, 電気伝導率, 温度依存性, 機能素子, 耐熱性高分子, ポリイミド, 分子素子, Langmuir膜, Langmuir-Blodgett膜

準シソーラス用語:LB膜

▲このページの先頭へ

 ANSWER 65 OF 74 JSTPLUS JST COPYRIGHT

整理番号:86A0406439

和文標題:ポリイミド累積膜の作製とその電気的特性

英文標題:Preparation of polyimide accumulation membrane and its electrical characteristics.

著者名:鈴木正明, 岩本光正, 日野太郎, 柿本雅明, 今井とし夫 (東京工大)

資料名:電気学会電子材料研究会資料 JST資料番号:Z0970A

巻号ページ(発行年月日):Vol.EFM-86 No.14-17.19-21 Page.11-20 (1986.06.24) 写図表参:写図9, 表5, 参22

資料種別:会議録(C) 記事区分:原著論文(a1)

発行国:日本(JPN) 言語:日本語(JA)

抄録:水面上に形成の単分子膜を基板上に累積するLB法で作製したポリイミド累積膜は電気的諸特性にすぐれ従来のLB膜の欠点を補える材料と考えられるが,さらに作製の第一段階で付与した長鎖アルキル基を第三段階のイミド化処理によって脱離除去するから1層の累積当り約4 Åの超薄膜をうることができ,ポリイミドの利用拡大と共に実用化が期待できる

分類コード:NC03020K, CG02024U, BK14070L (621.315.5, 544.23-16:535/538, 539.23:547)

シソーラス用語:累積, 多層膜, 高分子膜, 単分子層, 膜厚, X線干渉計, 紫外スペクトル, 静電容量, 電流電圧特性, 電気伝導率, 温度依存性, 耐熱性, ポリイミド

準シソーラス用語:LB法

▲このページの先頭へ

全てをチェックする

■ ダウンロード項目を選択してください

ダウンロード形式

- 印刷用形式(検索式付き)
- タブ区切り形式(検索式なし)
- Refer/BibIX形式(検索式なし)

チェックした回答をダウンロード

■ 表示している文献の複写申し込み

チェックした回答の複写を申し込む

文献複写には別途料金がかかります

---

画面印刷

閉じる